

L'électrostatique

«La force répulsive de deux petits globes électrisés de la même nature d'électricité est en raison inverse du carré de la distance du centre des deux globes.» CHARLES AUGUSTIN COULOMB (1736-1806)

PLAN DU CHAPITRE

Ι	Loi	fondamentale de l'électrostatique : la loi de Coulomb	3
	I.1	Expression de la force de Coulomb (1785)	3
	I.2	Ordre de grandeurs	3
\mathbf{II}	Cha	amp électrostatique engendré par des distributions discrètes de charges	4
	II.1	Définition et expression pour une charge ponctuelle	4
	II.2	Cas d'une distribution de charges ponctuelles : principe de superposition	4
III	Cha	amps engendrés par les distributions continues de charges	5
	III.1	Les 3 modèles de distributions de charge continues - échelle mésoscopique \dots	5
	III.2	Equivalence des modèles (sur un exemple)	5
IV	\mathbf{Syn}	nétries et invariances des distributions de charges - Conséquences sur le	
	cha	mp	6
	IV.1	Eléments de symétrie des distributions de charges	6
	IV.2	Invariances des distributions de charges	8
	IV.3	Quelques exemples d'exploitation	10
\mathbf{V}	Le p	potentiel électrostatique	10
	V.1	Circulation du champ d'une charge ponctuelle - circulation conservative	10
	V.2	Première approche du potentiel - indétermination	11
	V 3	Notions énergétiques - lien avec le potentiel	14

VI	Le tl	néorème de Gauss	16		
	VI.1	Flux du champ électrique - Enoncé	16		
	VI.2	Exemples d'application (à connaître !!!!)	18		
	VI.3	Retour sur le potentiel - continuité - principe de calcul	19		
VII	I Noti	ons élémentaires sur le condensateur plan	20		
	VII.1	Définition - Capacité	20		
	VII.2	Cas du condensateur plan (à connaître parfaitement)	21		
	VII.3	Lois d'association	22		
	VII.4	Energie stockée dans un condensateur	22		
VIII Analyse topographique du champ et du potentiel					
	VIII.1	Lignes de champ	23		
	VIII.2	Tubes de champ (ou tube de LDC)	25		
	VIII.3	Isopotentielles	25		
	VIII.4	Positions relatives des lignes de champs : resserrement ou évasement	26		
	VIII.5	Quelques cartes de champs et d'isopotentielles	27		

I Loi fondamentale de l'électrostatique : la loi de Coulomb

I.1 Expression de la force de Coulomb (1785)

A RETENIR:

- <u>Définition I-1</u>: Force de Coulomb —

La force exercée entre deux charges ponctuelles, par exemple q_1 et q_2 ou ${f force\ de\ Coulomb}$ s'écrit :

$$\begin{cases} \overrightarrow{F}_{1/2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{M_1M_2^2} \overrightarrow{u_{12}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{M_1M_2^3} \overrightarrow{M_1M_2} & \text{pour la force exercée par } q_1 \text{ sur } q_2 \\ \overrightarrow{F}_{2/1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{M_1M_2^2} \overrightarrow{u_{21}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{M_1M_2^3} \overrightarrow{M_2M_1} & \text{pour la force exercée par } q_2 \text{ sur } q_1 \end{cases}$$

avec $\epsilon_0 = 8,854.10^{-12} F.m^{-1} \; (USI)$ permittivité diélectrique du vide.

- ightharpoonup si $q_1q_2>0$ les deux forces réciproques sont répulsives
- lacktriangle si $q_1q_2<0$ les deux forces réciproques sont attractives

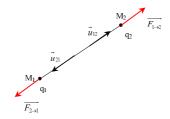


FIGURE XI.1 – Définition de la loi de Coulomb (ici dans le cas $q_1q_2 > 0$)

Remarque I-1: ANALOGIE —

La loi de Coulomb présente une analogie de forme importante avec la loi de la gravitation, toutes deux présentant une dépendance en $\frac{1}{r^2}$:

$$\overrightarrow{F}_{2/1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{\textcolor{red}{r^2}} \overrightarrow{u}_{21} \iff \overrightarrow{F}_{m_2/m_1} = -Gm_1m_2 \frac{1}{\textcolor{red}{r^2}} \overrightarrow{u}_{21}$$

1.2 Ordre de grandeurs

- Force électrostatique entre l'électron et le proton d'un atome H (Modèle planétaire de l'atome d'hydrogène) : $F_{p/e}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{a_0^2}\sim 10^{-9}N$
- Force d'interaction gravitationnelle entre l'électron et le proton d'un atome $H:F_{grav}=G\frac{m_em_p}{a_0^2}\sim 10^{-47}N$
- \blacktriangleright Poids de chacune des particules : $P_e=m_eg\simeq 9.10^{-30}N$ et $P_p=m_pg\simeq 10^{-26}N$

A RETENIR :
$$F_{grav} << P_{e/p} << \underbrace{F_{Coulomb}}_{\mbox{\scriptsize la force de Coulomb est une interaction forte}}$$

Champ électrostatique engendré par des distributions discrètes de charges

Définition et expression pour une charge ponctuelle

Définition II-1: CHAMP D'UNE CHARGE PONCTUELLE

On appelle champ électrostatique créé en un point M par une charge ponctuelle q_i placée en P_i , la force ressentie par une charge d'essai q placée en M, divisée par la valeur de cette charge q;

Si $\begin{cases} q_i \text{ est en } P_i \\ q \text{ est une charge d'essai en } M \end{cases}$ alors le champ électrostatique créé par q_i en M est la force ressentie

$$\overrightarrow{\overline{E}}_{q_i}(M) = \frac{\overrightarrow{F}_{P_i \to M}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M^2} \overrightarrow{u}_{P_i M}$$

On retiendra également l'expression de la force de Coulomb :

$$\overrightarrow{F}_{q_i \to q} = q \overrightarrow{E}_{q_i}(M)$$

II.2 Cas d'une distribution de charges ponctuelles : principe de superposition

Calcul du champ

On pose la situation suivante :

- ▶ n charges q_i (i = 1..n) sont placées en des points P_i .
- \blacktriangleright Une charge d'essai q est placé en M.
- ▶ On note $\overrightarrow{u_i} = \frac{P_i M}{P_i M}$

alors la charge d'essai en M va subir la force électrostatique résultante suivante:

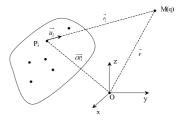


FIGURE XI.2 - Distribution ponctuelle de charges

$$\overrightarrow{F}_{el}[M(q)] = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F}_{i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{i}q}{P_{i}M^{2}} \cdot \overrightarrow{u_{i}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} q_{i}q \frac{\overrightarrow{P_{i}M}}{P_{i}M^{3}}$$

soit d'après sa définition, le champ électrostatique en M s'écrit :

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{1}{q} \overrightarrow{F}_{el}[(q)] = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M^2} \cdot \overrightarrow{u_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{P_i M}}{P_i M^3}$$

b - Exemples simples

<u>Exercice de cours:</u> (II.2) - n° 1. Champ produit par une distribution élémentaire Déterminer le champ produit par 3 charges (2q,q,q), chacune placée à un sommet d'un triangle équilatéral de côté a en son barycentre G.

III Champs engendrés par les distributions continues de charges

Lorsque les charges sont ponctuelles et dénombrables (distribution discrète), nous avons vu que le champ électrostatique d'une telle distribution se calculait par la superposition des champs engendrés par chaque charge :

$$(q_1, q_2, \dots, q_i) \longrightarrow \overrightarrow{E}(M) = \sum_i \overrightarrow{E_i}(M)$$

 $\underline{\text{QUESTION}}$: comment procéder lorsque la source du champ est une distribution de charge est continue, i.e. distance typique entre charges très inférieure à la distance caractéristique d'analyse du problème?

III.1 Les 3 modèles de distributions de charge continues - échelle mésoscopique

Propriété III-1: -

Lorsqu'une distribution \mathcal{D} de charge peut être considérée comme continue (i.e. charges non dénombrables et à faible distance les unes des autres par rapport à la distance caractéristique du problème), on caractérise la charge de \mathcal{D} par une grandeur nivelée mésoscopique appelée densité de charge.

On retiendra 3 modèles de distributions classiques :

III.2 Equivalence des modèles (sur un exemple)

Prenons le cas d'un fil rectiligne de rayon r, chargé, et isolons un élément de longueur dl.

A RETENIR:

La charge locale $\delta Q(M)$ peut s'écrire de manière équivalente selon 2 modèles de répartition continue.

▶ La charge est répartie en surface du fil \Rightarrow équivalence $1D \leftrightarrow 2D$

$$\delta Q(M) = \sigma(M)2\pi r \cdot dl = \lambda(M) \cdot dl$$

donc :
$$\lambda(M) = 2\pi r \sigma(M)$$

▶ La charge est répartie en volume dans le fil \Rightarrow équivalence $1D \leftrightarrow 3D$

$$\delta Q(M) = \rho(M)d\tau = \rho(M) \cdot \pi r^2 \cdot dl = \lambda(M) \cdot dl$$

 $\mathrm{donc}: \boxed{\lambda(M) = \pi r^2 \rho(M)}$

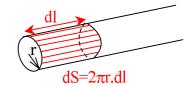


FIGURE XI.6 – Equivalence de modèles de charge $1D \leftrightarrow 2D$

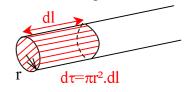


FIGURE XI.7 – Equivalence de modèles de charge $1D \leftrightarrow 3D$

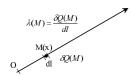


FIGURE XI.3 — Distribution 1D Lorsqu'un corps chargé possède une dimension l dominant les deux autres, par exemple un fil dont les dimensions de section sont très petites face à la longueur, on peut définir la charge linéïque de ce corps, c'est à dire la charge par unité de distance :

$$\lambda(P) = \frac{\delta Q(P)}{dl}$$

$$\Rightarrow d\vec{E}(M)_{\delta Q(M)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\frac{\delta Q(P)}{\lambda(P) \cdot dl}}_{PM^2} \cdot \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{D}} \underbrace{\frac{\delta Q(P)}{\lambda(P) \cdot dl}}_{PM^2} \cdot \vec{u}$$

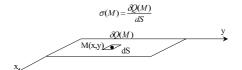


FIGURE XI.4 — Distribution 2D La distribution bidimensionnelle est retenue lorsque deux dimensions du corps chargé dominent la troisième, ou que les charges du corps sont exclusivement réparties en surface (cas des conducteur en équilibre électrostatique par exemple). On peut définir la charge surfacique :

$$\sigma(P) = \frac{\delta Q(P)}{dS}$$

$$\Rightarrow d\overrightarrow{E}(M)_{\delta Q(P)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\overbrace{\sigma(P) \cdot dS}^{=\delta Q(P)} \cdot dS}_{PM^2} \cdot \overrightarrow{u}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\mathcal{D}} \underbrace{\overbrace{\sigma(P) \cdot dS}^{=\delta Q(P)}}_{PM^2} \cdot \overrightarrow{u}$$

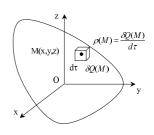


FIGURE XI.5 – Distribution 3D Dans le cas le plus général d'un corps chargé en volume, on peut définir la densité volumique

$$\rho(P) = \frac{\delta Q(P)}{d\tau}$$

$$\Rightarrow d\overrightarrow{E}(M)_{\delta Q(P)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\overbrace{\rho(P)}^{=\delta Q(P)} \cdot d\tau}_{PM^2} \cdot \overrightarrow{u}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \underbrace{\overbrace{\rho(P) \cdot d\tau}_{PM^2}}_{PM^2} \cdot \overrightarrow{u}$$

IV Symétries et invariances des distributions de charges - Conséquences sur le champ

IV.1 Eléments de symétrie des distributions de charges

a - Plan de symétrie - conséquences sur le champ

Définition IV-1: PLAN DE SYMÉTRIE —

Une distribution de charge admet un plan de symétrie Π^+ lorsque les charges élémentaires, placées en deux points symétriques P et P' de cette distribution, sont égales.

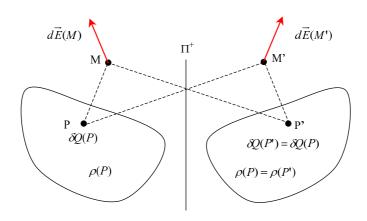


FIGURE XI.8 – Plan de symétrie d'une distribution de charge

Evaluons le champ élémentaire produit en M et en $M'=sym_{\Pi^+}(M)$ par les charges des points P et $P'=sym_{\Pi^+}(P)$:

$$d\overrightarrow{E}(M) = \frac{\delta Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3} + \frac{\overrightarrow{P'M}}{P'M^3} \right) \quad et \quad d\overrightarrow{E}(M') = \frac{\delta Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\overrightarrow{PM'}}{PM'^3} + \frac{\overrightarrow{P'M'}}{P'M'^3} \right)$$

$$\text{puisque } \begin{cases} PM = P'M' & \text{et } P'M = PM' \\ \overrightarrow{P'M'} = sym_{\Pi^+}(\overrightarrow{PM}) & \text{et } \overrightarrow{PM'} = sym_{\Pi^+}(\overrightarrow{P'M}) \end{cases}$$

 $d\overrightarrow{E}(M') = sym_{\Pi^+} \left[d\overrightarrow{E}(M) \right]$

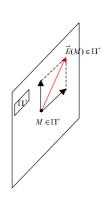
ce qui conduit à la relation très générale du caractère symétrique du champ électrique : $\underbrace{A\ \text{RETENIR}\ :}$

$$\boxed{\overrightarrow{E}(M') = sym_{\Pi^+} \left[\overrightarrow{E}(M)\right]} \Longrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M') = \overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M) \\ \overrightarrow{E}_{\perp}(M') = -\overrightarrow{E}_{\perp}(M) \end{cases}$$

Conséquence importante :

Pour un point
$$M=M'\in\Pi^+$$
, on a $\overrightarrow{E}_\perp(M=M')=-\overrightarrow{E}_\perp(M=M')$ soit $\overrightarrow{E}_\perp(M=M')=\overrightarrow{0}$ et donc $\overrightarrow{E}(M=M'\in\Pi^+)=\overrightarrow{E}_\parallel(M=M'\in\Pi^+)$

$$\Longrightarrow \overrightarrow{E}(\forall M \in \Pi^+) \in \Pi^+$$



b - Plan d'antisymétrie - conséquences sur le champ

Définition IV-2: Plan d'antisymétrie —

Une distribution de charge possède un plan d'antisymétrie Π^- lorsque les charges élémentaires placées en deux points P et P' symétriques par rapport à Π^- sont opposées.

On dégage facilement, par une démonstration analogue à celle menée plus haut, que pour une distribution de charge présentant un plan d'antisymétrie Π^- on a entre M' et M avec $M'sym_{\Pi^+}(M)$:

$$\overrightarrow{E}(M') = -sym_{\Pi^{-}} \left[\overrightarrow{E}(M)\right] \Longrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M') = -\overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M) \\ \overrightarrow{E}_{\perp}(M') = +\overrightarrow{E}_{\perp}(M) \end{cases}$$

Conséquence importante :

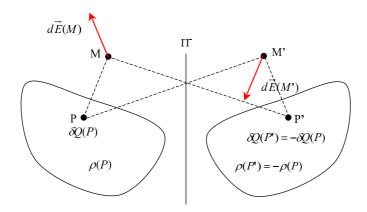
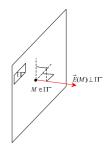


FIGURE XI.9 – Plan d'antisymétrie d'une distribution de charge

Pour un point
$$M=M'\in\Pi^-$$
, on a $\overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M=M')=-\overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M=M')$ soit $\overrightarrow{E}_{/\!\!/}(M=M')=\overrightarrow{0}$ et donc $\overrightarrow{E}(M=M'\in\Pi^-)=\overrightarrow{E}_{\perp}(M=M'\in\Pi^-)$
$$\Longrightarrow \overrightarrow{E}(\forall M\in\Pi^-)\perp\Pi^-$$



IV.2 Invariances des distributions de charges

PRÉLIMINAIRE: Transformations isométriques du champ.

 \overline{NB} : on indiquera dans la suite toutes les images par rapport à une transformation quelconque par l'ajout de l'exposant <<'>>.

On a alors:

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{PM^3} \overrightarrow{PM} \implies \overrightarrow{E}'(M') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{P'M'^3} \overrightarrow{P'M'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{PM^3} \overrightarrow{P'M'}$$

 $\underline{\mathrm{CONCLUSION}}$: pour une transformation isométrique le champ électrique \overrightarrow{E} se transforme comme le vecteur \overrightarrow{PM} .

a - Cas de la translation - conséquences sur le champ

On suppose une distribution de charge telle qu'une translation, par exemple $\overrightarrow{T} = a \cdot \overrightarrow{e_z}(\forall a)$, laisse cette dernière invariante soit : $\rho(\forall M) = \rho'(\forall M)$

On parle alors d'invariance par translation (recouvrement).

 ${\bf NB}$: une telle distribution de charge n'existe pas dans la mesure où l'extension spatiale de la distribution est nécessairement finie.

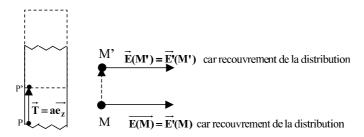


Figure XI.10 – Invariance par translation

Nous savons que le champ se transforme comme le vecteur \overrightarrow{PM} or une translation laisse invariante le vecteur $\overrightarrow{PM}:\overrightarrow{P'M'}=\mathcal{T}(\overrightarrow{PM})=\overrightarrow{PM}$; il vient donc :

$$\overrightarrow{E}(M') = \overrightarrow{E}(M)$$

Conséquences : dans notre cas de la translation $\overrightarrow{T} = a \cdot \overrightarrow{e_z}$ selon $\overrightarrow{e_z}$, cette égalité devient :

$$\overrightarrow{E}(x,y,z) = \overrightarrow{E}(x,y,z') = \overrightarrow{E}(x,y,\forall z) = \overrightarrow{E}(x,y) \neq f(z)$$

Propriété IV-1: Invariances par translation —

Si on a invariance par translation d'une distribution de charge alors le champ électrique engendré ne dépend pas de la variable spatiale attachée à l'axe de cette translation.

b - Cas de la rotation - conséquences sur le champ

On suppose maintenant une distribution de charge telle qu'une rotation, par exemple \mathcal{R}_{θ} selon l'axe $\overrightarrow{e_z}$, laisse cette dernière invariante, soit formellement : $\rho(\forall M) = \rho'(\forall M)$. On parle alors d'invariance par rotation (recouvrement).

Le champ se transformant comme le vecteur \overrightarrow{PM} , on a dans le cas d'une rotation on a : $\begin{cases} \overrightarrow{P'M'} \neq \overrightarrow{PM} \\ P'M' = PM \end{cases}$

Par conséquent : \rightarrow

$$|\overrightarrow{E}(M')| = |\overrightarrow{E}(M)|$$

 $\underline{ ext{Conséquences}}$: Dans notre cas de la rotation $\mathcal{R}_{ heta}$ d'axe $\overrightarrow{e_z}$, cette égalité devient :

$$|\overrightarrow{E}(\rho, \theta(M), z)| = |\overrightarrow{E}(\rho, \theta(M) + \theta_0, z)| \stackrel{\forall \theta_0}{=} |\overrightarrow{E}(\rho, \forall \theta, z)| = |\overrightarrow{E}(\rho, z)| \neq f(\theta)$$

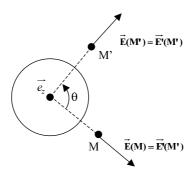


FIGURE XI.11 – Invariance par rotation

Propriété IV-2: Invariance par rotation —

Si une distribution de charge est invariante par rotation alors la norme du champ électrique ne dépend pas de la variable angulaire attachée à cette rotation.

IV.3 Quelques exemples d'exploitation

<u>Exercice de cours:</u> (IV.3) - n° 2. Dégager les éléments de symétrie et les invariances des distributions de charges suivantes. Conclusion pour le champ électrique. :

- Le "triangle équilatéral de charges" évoqué au II.2.b. Propriété du champ au point G barycentre du triangle.
- **2** Carré de charges identiques. Champ au point G barycentre du carré.
- **3** Plan infini de charge surfacique σ homogène et placé en z=0
- Cylindre infini chargé en volume de manière homogène

V Le potentiel électrostatique

V.1 Circulation du champ d'une charge ponctuelle - circulation conservative

On considère une charge ponctuelle q placée au point O origine du repère. Le champ créé en en un point $M(r, \theta, \varphi)$ (coordonnées sphériques) est :

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \cdot \overrightarrow{e_r}$$

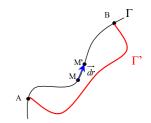
Définition V-1: CIRCULATION DU CHAMP ÉLECTRIQUE -

ullet On appelle circulation élémentaire du champ \overrightarrow{E} associée au déplace-

ment
$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{dr} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}_{\left(\overrightarrow{e_{x}}, \overrightarrow{e_{y}}, \overrightarrow{e_{z}}\right)} = \begin{pmatrix} dr \\ rd\theta \\ r\sin\theta d\varphi \end{pmatrix}_{\left(\overrightarrow{e_{r}}, \overrightarrow{e_{\theta}}, \overrightarrow{e_{\phi}}\right)}$$
 la quantité

scalaire:

$$d\mathcal{C} = \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{e_r} \cdot \overrightarrow{dr}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\left(-\frac{1}{r}\right)$$



• La circulation du point A au point B s'obtient par intégration sur un trajet Γ (ne passant pas par le point O pour éviter toute divergence du champ \overrightarrow{E} !), soit :

$$C_{AB}(\overrightarrow{E}) = \int_{A}^{B} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \left(\frac{1}{r_{A}} - \frac{1}{r_{B}} \right) \neq f(\Gamma)$$

Propriété V-1: Conservation de la circulation

La circulation du champ électrique créé par une charge ponctuelle entre deux points A et B de l'espace est indépendante du chemin suivi ; soit deux chemins Γ et Γ' distincts alors :

$$\mathcal{C}_{(AB_{\Gamma})}(\overrightarrow{E}) = \mathcal{C}_{(AB_{\Gamma}')}(\overrightarrow{E}) = \mathcal{C}_{(AB_{\forall \Gamma})}(\overrightarrow{E}) \neq f(\Gamma)$$

⇒ La circulation du champ créé par une charge ponctuelle est dite conservative

▶ La circulation du champ électrique engendré par une charge ponctuelle sur un trajet Γ fermé est nulle (point de départ \equiv point d'arrivée) :

$$\mathcal{C}_{\Gamma \ ferm} = \oint_{\Gamma} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = 0$$

V.2 Première approche du potentiel - indétermination

a - Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle

On suppose toujours une charge ponctuelle placée en O. On a :

$$d\mathcal{C} = \overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) \cdot \overrightarrow{dr} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{e_r} \cdot d\overrightarrow{r}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\left(\frac{1}{r}\right) = -d\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + cste\right)$$

soit $d\mathcal{C} = -dV(r)$ si l'on pose :

 $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + cste$ le potentiel électrostatique engendré en M par la charge ponctuelle q

Remarque V-1: INDÉTERMINATION DU POTENTIEL -

Le potentiel électrostatique est indéterminé car défini à une constante près ! \Longrightarrow on doit choisir une convention d'origine (CL).

Convention:
$$V(r \to \infty) = 0 \Longrightarrow cste = 0$$

A RETENIR : potentiel d'une charge ponctuelle centrée en O(r=0) : $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$

Potentiel électrostatique créé par une distributions de charges : principe de superposition

Considérons une distribution de charges ponctuelles $\mathcal{D}=(q_1,q_2\dots q_n)$, ces charges étant respectivement placées aux points (P_1,P_2,\ldots,P_n) . Le champ engendré par cette distribution de charges en un point M quelconque est :

$$\overrightarrow{E}(M) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M^2} \cdot \overrightarrow{u_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \cdot \overrightarrow{u_i} \quad \text{en posant } r_i = P_i M$$

La circulation élémentaire du champ électrique sur un déplacement \overrightarrow{dr} du point M est donc :

$$d\mathcal{C} = \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \cdot \overrightarrow{u_i} \cdot \overrightarrow{dr}$$

Par ailleurs, on a :
$$\overrightarrow{u_i} \cdot \overrightarrow{dr} = \overrightarrow{u_i} \cdot d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{u_i} \cdot \left(\underbrace{d\overrightarrow{OP_i}}_{=\overrightarrow{0}} + \underbrace{d\overrightarrow{P_iM}}_{=d\overrightarrow{r_i}}\right) = dr_i$$

on obtient :

$$d\mathcal{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \cdot dr_i = -\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} d\left(\frac{1}{r_i}\right) = -d\left(\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_i}\right) + \underbrace{cste_i}_{=0 \text{ par convention}}\right)$$

A RETENIR: Ainsi:

$$d\mathcal{C} = -dV$$

avec V(M) le potentiel électrostatique en M de la distribution de charges : $V(M) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0}$

$$: V(M) = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_i}\right)$$

c - Calcul de la différence de potentiel entre deux points

Pour calculer la différence de potentiel entre deux points A et B, on évalue simplement la circulation du champ électrostatique entre ces deux points A et B sur un trajet Γ (quelconque) :

$$C_{AB}(\overrightarrow{E}) = \int_{A}^{B} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = -\int_{A}^{B} dV = V(A) - V(B)$$

- Remarque V-2: CIRCULATION CONSERVATIVE —

- \blacktriangleright La circulation du champ électrostatique engendré par une distribution quelconque est conservative (indépendante du trajet Γ).
- ► La circulation du champ électrostatique engendré par une distribution quelconque est nulle sur un contour fermé :

$$C_{\Gamma \ ferm} = \oint_{\Gamma} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = -\oint_{\Gamma} dV = 0$$

d - Lien champ-potentiel : l'opérateur gradient

Supposons une distribution de charge \mathcal{D} engendrant un champ $\overrightarrow{E}(M)$ en tout point M de l'espace. On se place en coordonnées cartésiennes de base orthonormée directe $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$. Les coordonnées du champ en M dans cette base sont :

$$\overrightarrow{E}(M) = \begin{pmatrix} E_x(M) \\ E_y(M) \\ E_z(M) \end{pmatrix}_{(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})}$$

La circulation élémentaire sur le trajet $\overrightarrow{dr} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}_{(\overrightarrow{ex},\overrightarrow{ey},\overrightarrow{ez})}$ s'écrit :

$$d\mathcal{C} = \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = E_x \cdot dx + E_y \cdot dy + E_z \cdot dz$$

de plus, la variation élémentaire du potentiel s'écrit :

$$dV(x,y,z) = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial V}{\partial z} \cdot dz \quad \text{(différentielle d'une fonction à plusieurs variables)}$$

or par ailleurs on a $d\mathcal{C} = -dV$ donc

$$\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = E_x \cdot dx + E_y \cdot dy + E_z \cdot dz = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial V}{\partial z} \cdot dz\right] = -\overrightarrow{grad}V \cdot \overrightarrow{dr}$$

en posant un nouveau vecteur appelé gradient du potentiel et noté $\overrightarrow{grad}V$ tel que :

$$\overrightarrow{grad}V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix} \text{ et par identification } \overrightarrow{E}(M) = -\overrightarrow{grad}V(M)$$

Ainsi, le champ électrostatique en un point M et le potentiel électrostatique en ce même point sont liés par la relation suivante (on dit que le champ dérive du potentiel) :

A RETENIR:

$$\overrightarrow{E}(M) = -\overrightarrow{grad}V(M)$$
 et $\overrightarrow{dV} = \overrightarrow{grad}V(M) \cdot \overrightarrow{dr}$

On exploite généralement ce vecteur dans les systèmes de coordonnées classiques :

- ▶ Coordonnées cartéconnaître)
- siennes : (expression à
- ► Coordonnées cylindriques : (expression donnée en énoncé si nécessaire)
- ► Coordonnées sphériques : (expression donnée énoncé si nécessaire)

$$\overrightarrow{grad}V(x,y,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{grad}V(\rho,\theta,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{grad}V(\rho,\theta,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{grad}V(r,\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

Remarque V-3: Opérateur Nabla

On définit parfois l'opérateur gradient à l'aide de l'opérateur «nabla», valable uniquement en coordon-

$$\begin{array}{ll} \textbf{n\'ees cart\'esiennes} \ \textbf{comme suit} : \overrightarrow{grad} \left[V(x,y,z) \right] = \overrightarrow{\nabla} V \quad avec : \quad \overrightarrow{\nabla} = \begin{pmatrix} \overline{\partial x} \\ \frac{\partial y}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

INTERPRÉTATION PHYSIQUE DU GRADIENT : en live!

V.3 Notions énergétiques - lien avec le potentiel

Travail de la force de Coulomb - lien avec le potentiel

Considérons une charge q dans une région où règne un champ électrostatique \overrightarrow{E} . Lors d'un déplacement élémentaire \overrightarrow{dr} de cette charge, le travail de la force de Coulomb exercée sur celle-ci s'écrit :

$$\delta W_{Coul} = \overrightarrow{F}_{q} \cdot \overrightarrow{dr} = q \cdot \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = -q \cdot \overrightarrow{grad} V \cdot \overrightarrow{dr} = -q \cdot dV$$

soit (A RETENIR:):

$$\delta W_{Coul} = -q \cdot dV$$

Le travail dépensé par cette force sur le trajet AB est obtenu par intégration avec :

$$W_{Coul_{AB}} = -q\int\limits_A^B dV = q\left[V(A) - V(B)
ight]$$
 (Indépendant du chemin suivi!)

b - Energie électrostatique d'une charge ponctuelle placée dans un champ électrostatique extérieur

Considérons un opérateur amenant une charge ponctuelle q depuis l'infini (absence de sources) où règne un potentiel nul, jusqu'à une position finale M de potentiel V(M) et de champ $\overrightarrow{E}(M)$.



FIGURE XI.12 – Travail d'un opérateur

Les forces travaillant lors de cette opération sont : $\begin{cases} La \text{ force de Coulomb} \\ La \text{ force exercée par l'opérateur} \end{cases}$

L'application du théorème de l'énergie cinétique entre les positions infini et M conduit à :

$$\Delta E_c = W_{Coul} + W_{op}$$

En outre, la charge ayant une vitesse nulle en positions initiale et finale, on a $\Delta E_c = 0$ ce qui conduit à :

$$W_{op} = -W_{coul} = -q \left[V(\infty) - V(M) \right] = qV(M) = E_p \quad \text{énergie potentielle électrostatique}$$

<u>Définition V-2</u>: Energie électrostatique —

On définit l'énergie potentielle électrostatique $E_p(M)$ d'une charge ponctuelle q plongée dans un champ électrostatique $\overrightarrow{E(M)}$ comme le travail dépensé par un opérateur qui amènerait cette charge de l'infini, où règne un potentiel $V(\infty)=0$, en une position finale M, où règne un potentiel $V(M)\neq 0$:

$$E_p(M) = qV(M)$$

Le théorème de Gauss

VI.1 Flux du champ électrique - Enoncé

Définition - surface orientée et flux

On considère une surface à laquelle on associe une orientation. 2 cas de figure peuvent se présenter :

▶ Si la surface S est ouverte, elle est orientée par un ▶ Si la surface S est fermée, elle est orientée par un vecteur unitaire local (en P) $\overrightarrow{n}(P)$ avec :

vecteur unitaire local (en P) $\overrightarrow{n}(P)$ avec :

$$\begin{cases} \text{direction de } \overrightarrow{n} : \bot \mathcal{S} \\ \text{sens de } \overrightarrow{n} : \text{selon la règle d'Ampère} \end{cases}$$

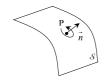


FIGURE XI.13 – Orientation d'une surface ouverte

 $\begin{cases} \text{direction de } \overrightarrow{n} : \bot \mathcal{S} \\ \text{sens de } \overrightarrow{n} : \text{vers l'extérieur de la surface.} \end{cases}$

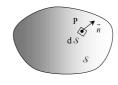
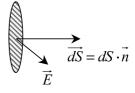


FIGURE XI.14 – Orientation d'une surface fermée

Définition VI-1: Flux d'un champ de vecteur

On appelle flux élémentaire d'un champ de vecteurs \overrightarrow{E} à travers la surface élémentaire \overrightarrow{dS} la quantité :

$$d\Phi(P) = \overrightarrow{E}(P) \cdot \overrightarrow{dS}(P) = \overrightarrow{E}(P) \cdot \overrightarrow{n}(P) \cdot dS$$



Le flux total du champ de vecteurs \overrightarrow{E} à travers la surface ${\mathcal S}$ s'obtient par intégration :

$$\Phi = \iint_S \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_S \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{n} \cdot dS \quad \text{si la surface } S \text{ est ouverte}$$

$$\Phi = \iint_S \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_S \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{n} \cdot dS \quad \text{si la surface } S \text{ est fermée}$$

$$\Phi = igoplus_S \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = igoplus_S \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{n} \cdot dS$$
 si la surface S est fermée

Enoncé du théorème de Gauss (admis)

A RETENIR:

Propriété VI-1: Théorème de Gauss –

Le flux du champ électrique engendré par un distribution quelconque de charges sur une surface fermée S quelconque de l'espace vaut :

$$\Phi = \iint\limits_{S} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \sum_{i} \frac{q_{i}}{\epsilon_{0}} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_{0}}$$
 cas des distributions discrètes

Ce résultat peut-être immédiatement étendu au cas des distributions continues, par exemple volumique de densité ρ :

$$\Phi = \iint\limits_{S} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint\limits_{V/S} \rho(M) \cdot d\tau = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \qquad \text{cas des distributions continues}$$

en appelant ρ la densité de charge dans le volume V de frontière la surface S.

Phrase à retenir : le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge totale contenue dans la surface fermée divisée par ϵ_0 .

c - Stratégie et conditions de mise en œuvre (à connaître parfaitement!!!)

A RETENIR : le théorème de Gauss est un puissant outil de détermination du champ électrique en tout point de l'espace dans les cas où les distributions de charges sources présentent un haut degré de symétrie et d'invariances (cylindre, sphère,plan infinis etc..)!!!

L'application du théorème de Gauss passe par 3 étapes essentielles : (à connaître parfaitement!!!)

- ▶ Identification des plans de symétrie et antisymétrie des sources ⇒ direction du champ connue en tout point de l'espace.
- ▶ Identification des invariances de la distribution source ⇒ variables "vraies" du champ connues.
- ▶ On pose le théorème de Gauss ⇒

$$\iint\limits_{S} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

et on choisit la surface de Gauss fermée $S \stackrel{\text{\'eventuellement}}{=} S_1 \cup S_2 \cup \ldots \cup S_i \cup \ldots \cup S_n$ telle que sur chaque élément de surface $\overrightarrow{dS_i}$ on ait :

Ainsi le théorème de Gauss devient :

$$\iint_{S} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_{0}} \implies = \pm \iint_{S_{1}} E \cdot dS \pm \iint_{S_{2}} E \cdot dS \dots \iint_{S_{m}} E \cdot dS = E \sum_{i}^{m \le n} \pm \iint_{S_{i}} dS_{i} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_{0}} \implies E = \frac{\frac{Q_{int}}{\epsilon_{0}}}{\sum_{i}^{m \le n} \pm S_{i}}$$

Le champ \overrightarrow{E} est alors déterminé.

VI.2 Exemples d'application (à connaître!!!)

a - Sphère uniformément chargée en volume - conséquences

On considère une sphère de rayon R et comportant une charge volumique homogène ρ_0 .

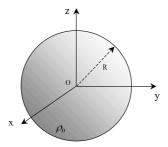


FIGURE XI.15 – sphère chargée uniformément en volume

<u>Exercice de cours:</u> (VI.2) - n° 3. Déterminer le champ électrique produit par cette distribution en tout point de l'espace.

b - Cylindre infini uniformément chargé en volume.

On considère un cylindre de section circulaire de rayon R et de longueur supposée infinie, et de charge volumique ρ_0 .

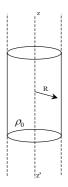


Figure XI.16 – Cylindre chargé uniformément en volume

Reprendre l'exercice précédent.

c - Plan infini uniformément chargé en z = 0.

On considère un plan de dimension infinie, chargée uniformément avec la densité surfacique σ_0 et placé à l'abscisse z=0.

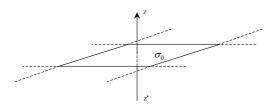


FIGURE XI.17 – Plan infini chargé uniformément

Reprendre là-encore l'exercice précédent.

VI.3 Retour sur le potentiel - continuité - principe de calcul

Rappelons la relation fondamentale liant champ et potentiel :

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{grad}V$$

qui donne après produit scalaire avec le déplacement élémentaire \overrightarrow{dR} :

$$\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} = -\overrightarrow{grad}V \cdot \overrightarrow{dr} \ \Rightarrow \ dV = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr}$$

Ainsi, on dégage la relation suivante à connaitre :

- **Propriété VI-2:** Calcul du potentiel à partir du champ —

Le potentiel se calcule à partir du champ électrique \overrightarrow{E} par la relation intégrale :

$$V(M) = -\int \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr} + cste$$

En explicitant, par exemple en coordonnées cartésiennes, la relation champ-potentiel, il vient :

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{grad}V = -\frac{\partial V}{\partial x} \cdot \overrightarrow{e_x} - \frac{\partial V}{\partial y} \cdot \overrightarrow{e_y} - \frac{\partial V}{\partial z} \cdot \overrightarrow{e_z}$$

Comme le champ électrique \overrightarrow{E} représente la force par unité de charge ressentie par une charge d'essai, et qu'une force possède une norme nécessairement finie, chacune des composantes du champ $E_x=\frac{\partial V}{\partial x}$, $E_y=\frac{\partial V}{\partial y}$, et $E_z=\frac{\partial V}{\partial z}$ est finie ; cela impose la continuité du potentiel V en tout point d'espace.

- Propriété VI-3: Continuité du potentiel -

Le potentiel électrostatique est continu en tout point d'espace.

Exemples de mise en oeuvre :

⇒ calcul du potentiel engendré par la sphère chargée, le plan infini chargé, le cylindre infini chargé : EN LIVE!!!

VII Notions élémentaires sur le condensateur plan

VII.1 Définition - Capacité

Définition VII-1: CONDENSATEUR -

On appelle condensateur, un ensemble de deux conducteurs en *influence totale* c'est à dire que si des charges existent sur ces conducteurs, alors toutes les lignes de champ émanant du 1er rencontre le 2nd sur leur passage. Les conducteurs sont appelés **armatures** du condensateur.

CONSÉQUENCE : une armature est contenue dans l'autre.

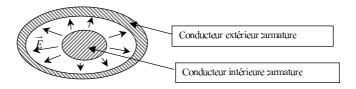


Figure XI.18 – Structure d'un condensateur "idéal"

 $\overline{\mathrm{NB}}$: les charges sont au repos dans les conducteurs donc $\overline{\overrightarrow{E}}=\overline{0}$ dans ceux-ci !

Supposons un condensateur au repos dont les armatures portent des charges, analysons la répartition des charges. Pour cela, appliquons le théorème de Gauss sur deux surfaces fermées distinctes :

 \blacktriangleright sur la surface fermée S_1 contenue dans l'armature intérieure 1 :

$$\iint\limits_{S_1} \underbrace{\overrightarrow{E}}_{=0} \cdot d\overrightarrow{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint\limits_{v_1} \rho \cdot d\tau = 0 \implies \rho_1 = 0$$

On en déduit que les charges de cette armature sont portées par sa surface $Q_1=\iint_{s_1}\sigma_1\cdot dS$ avec la densité surfacique $\sigma_1\neq 0$

ightharpoonup sur la surface fermée S_2 contenue dans l'armature 2 :

$$\iint\limits_{S_2} \underbrace{\overrightarrow{E}}_{=0} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}(S_2)}{\epsilon_0} = 0$$

$$Q(S_2) = Q_1 + Q_2(int) = 0$$

On en déduit que la charge portée par la surface intérieure de l'armature 2 est opposée à la charge de l'armature 1 en vis à vis : $Q_2(int) = -Q_1$

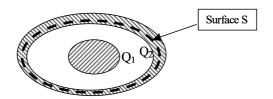


FIGURE XI.19 – Répartition des charges dans un condensateur "idéal"

On définit la capacité du condensateur de la manière suivante (définition admise sans démonstration) :

<u>Définition VII-2</u>: Capacité d'un condensateur —

Un condensateur chargé avec la charge Q_1 et présentant une différence de potentiel ΔV entre ses deux armatures possède la capacité C définie par :

$$C = \frac{Q_1}{\Delta V} \tag{XI.1}$$

Unité : C en Farad (F) si Q en Coulomb et ΔV en Volt.

VII.2 Cas du condensateur plan (à connaître parfaitement)

Le modèle du condensateur plan consiste en un ensemble de deux conducteurs plans infinis (épaisseur négligeable) en vis à vis. Ce modèle fictif est retenu lorsque l'écartement e d'armatures planes de dimension finie, est très inférieur aux dimensions du plan de surface S. On néglige donc les phénomènes intervenant aux extrémités ("effets de bords"). L'influence totale n'est donc pas assurée dans ce type de condensateur, le calcul de la capacité reste néanmoins applicable avec une très bonne approximation.

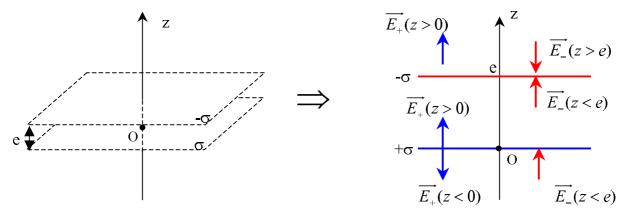


Figure XI.20 – Structure du condensateur plan

VALEUR DU CHAMP:

On rappelle que le champ engendré par un plan infini chargé avec la densité surfacique σ est : $\overrightarrow{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \overrightarrow{n_{ex}}$

Ainsi le champ résultant entre les plaques est : $\overrightarrow{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \overrightarrow{e_z}$ Calculons ensuite la différence de potentiel entre armatures :

$$V_1 - V_2 = \int_1^2 -dV = \int_1^2 -\overrightarrow{grad}V \cdot \overrightarrow{dOM} = \int_1^2 \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dOM} = E \times e = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \times e = \frac{Q_1 \times e}{S \times \epsilon_0}$$

Ce qui permet sans peine de déterminer la capacité de ce condensateur :

$$C_{plan} = \frac{\epsilon_0 \times S}{e}$$

Remarque VII-1: -

- \rightarrow dans le cas où l'espace d'un condensateur est rempli d'un matériau (isolant), l'expression de sa capacité C s'obtient simplement en remplaçant la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 par celle du matériau $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$ (avec ϵ_r permittivité diélectrique relative du matériau).
- \rightarrow la capacité d'un condensateur ne dépend que de ses caractéristiques propres (dimensions et matériau de remplissage)

VII.3 Lois d'association

EN LIVE!!!

VII.4 Energie stockée dans un condensateur

On considère un condensateur portant la charge Q_1 sur l'armature 1 et $Q_2=-Q_1$ sur l'armature 2, la différence de potentiel régnant entre les deux armatures étant $\Delta V=V_1-V_2$. Imaginons que l'on souhaite augmenter la charge du condensateur en donnant une charge élémentaire dQ_1 sur l'armature 1 de potentiel V_1 , et $dQ_2=-dQ_1$ de potentiel V_2 (seconde borne du générateur).

Le travail total à fournir (par l'opérateur) pour réaliser cette opération est donc :

$$\delta W_{op} = V_1 \cdot dQ_1 + V_2 \cdot dQ_2 = [V_1 - V_2] \cdot dQ_1$$

en outre :

$$\Delta V = V_1 - V_2 = \frac{Q_1}{C}$$

d'où:

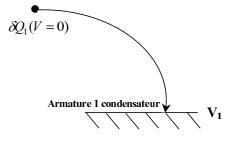


FIGURE XI.21 – Calcul de l'énergie d'un condensateur

$$\delta W_{op} = (V_1 - V_2) \cdot dQ_1 = \frac{Q_1}{C} \cdot dQ_1 = d\left(\frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{C}\right)$$

L'énergie fournie par l'opérateur étant accumulée dans le condensateur, on notera cette dernière U_{cond} avec donc :

$$\delta W_{op} = dU_{cond}$$

qui par intégration donne :

$$U_{cond} = \frac{1}{2} \int_{0}^{Q_1} d\left(\frac{Q_1^2}{C}\right)$$

$$U_{cond} = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C} = \frac{1}{2} C (V_1 - V_2)^2$$

A RETENIR:

- **Propriété VII-1:** Energie stockée dans un condensateur —

Lorsqu'un condensteur possède une charge $Q=C\Delta V$ sous la différence de potentiel ΔV , il stocke une énergie électrique U_{cond} d'expression :

$$U_{cond} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

VIII Analyse topographique du champ et du potentiel

VIII.1 Lignes de champ

a - Définition

Considérons un champ électrostatique \overrightarrow{E} . On appelle ligne de champ, la courbe tangente en tout point au vecteur champ électrique.

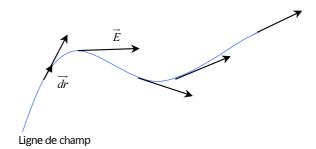


FIGURE XI.22 – Ligne de champ électrostatique

b - Obtention des équations de lignes de champs

La traduction formelle de la tangence des lignes de champ avec le champ s'écrit comme la colinéarité d'un élément $\overrightarrow{dOM} = \overrightarrow{dr}$ de ligne avec le champ \overrightarrow{E} , soit :

$$\overrightarrow{dOM} \wedge \overrightarrow{E} = \overrightarrow{0}$$
 (1)

soit par exemple en coordonnées cartésiennes :

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = 0 \implies \begin{bmatrix} E_z dy - E_y dz = 0 \\ E_x dz - E_z dx = 0 \\ E_y dx - E_x dy = 0 \end{bmatrix}$$

<u>Exercice de cours:</u> (VIII.1) - n° 4. Déterminer les équations des lignes du champ produit par un condensateur plan chargé avec une densité surfacique $\sigma: \overrightarrow{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \overrightarrow{e_z}$

<u>Exercice de cours:</u> (VIII.1) - n° 5. Déterminer les équations des lignes de champ d'une charge ponctuelle placé à l'origine O d'un repère quelconque.

RÉPONSE :

On rappelle le champ engendré par une charge ponctuelle en un point $M(r,\theta,\varphi)$:

$$\overrightarrow{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \overrightarrow{e_r}$$

L'équation (1) s'écrit :

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \begin{pmatrix} dr \\ rd\theta \\ r\sin\theta d\varphi \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \frac{1}{r^2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

 $(cste_1; cste'_1)$ $\theta = cste_1$ y

soit:

$$\begin{cases} \frac{\sin \theta}{r} \cdot d\varphi = 0 \\ 0 \\ \frac{d\theta}{r} \end{cases} \implies \begin{cases} \theta = cste \\ \varphi = cste' \end{cases}$$

Chaque ligne de champ, caractérisée par un couple de valeur (cste, cste'), est bien une droite passant par O pour une charge ponctuelle.

Propriété VIII-1: —

Si deux lignes du champ électrostatique se coupent en un point d'espace, alors le champ en ce point est :

 $\begin{cases} \text{ soit nul } \overrightarrow{E} = \overrightarrow{0} \text{ puisque le champ doit être tangent à deux lignes différentes.} \\ \text{ soit non défini} \Longrightarrow \text{le point est dit singulier (ex : sur une charge ponctuelle)}. \end{cases}$

VIII.2 Tubes de champ (ou tube de LDC)

On appelle tube de champ un faisceau de lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé. Les lignes de champ sont tangentes à la surface d'un tube de champ, et donc perpendiculaires au vecteur de la surface latérale :

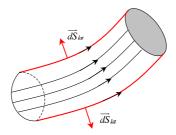


FIGURE XI.23 – Tube de champ électrostatique

VIII.3 Isopotentielles

Définition VIII-1: ISOPOTENTIELLE -

On appelle isopotentielle le lieu géométrique des points M d'espace pour lesquels le potentiel est constant. Dans un problème général (3D), cette zone d'espace correspond à une surface S_{iso} d'équation explicite :

$$M \in \mathsf{zone} \ \mathsf{isopotentielle} \Leftrightarrow V\left[M(x,y,z)\right] = cste$$

- Propriété VIII-2: ——

Le champ électrostatique est perpendiculaire à toute surface isopotentielle.

Plus généralement : Une surface définie par une équation explicite du type $f(x,y,z)=f(\overrightarrow{r'})=cste$ admet $\overrightarrow{grad}f$ comme vecteur normal.

<u>Démo</u>: considérons une surface S_{iso} isopotentielle de valeur V_0 et deux déplacements élémentaires $\overrightarrow{dr'}$ et $\overrightarrow{dr''}$ faisant passer respectivement de A à A' et A à A'' sur cette surface.

On a :
$$\begin{bmatrix} V(A') - V(A) = dV_{\overrightarrow{dr'}} = \overrightarrow{grad}V \cdot \overrightarrow{dr'} = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr'} = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0 \\ V(A'') - V(A) = dV_{\overrightarrow{dr''}} = \overrightarrow{grad}V \cdot \overrightarrow{dr''} = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr''} = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{AA''} = 0 \\ \Rightarrow \overrightarrow{E} \perp \overrightarrow{dr''} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{E} \perp \mathcal{S}_{iso}$$

Exemples: condensateur plan, charge ponctuelle EN LIVE!!!

Propriété VIII-3: -

Le champ électrostatique est orienté suivant les potentiels décroissants.

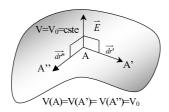


FIGURE XI.24 – Champ sur une surface isopotentielle

Supposons maintenant une ligne de champ traversant deux surfaces isopotentielles très proches respectivement aux points B et B' tels que $\overrightarrow{BB'}=dr'$, et supposons également que le champ soit orienté (décroissant) de B vers B'. Il vient :

$$dV = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dr'} = -||\overrightarrow{E}|| \times BB' < 0$$

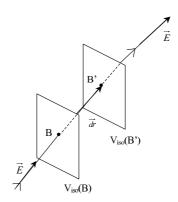


FIGURE XI.25 – Orientation du champ vers les potentiels décroissants

EXEMPLES: condensateur plan, charge ponctuelle EN LIVE!!!!

VIII.4 Positions relatives des lignes de champs : resserrement ou évasement

Envisageons un tube de champ dont les lignes de champ se resserrent :

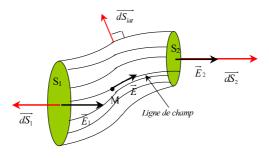


FIGURE XI.26 – Tube de champ resserré : les lignes de champ se resserrent

Appelons Σ la surface fermée du tube de champ telle que $\Sigma = S_1 \cup S_2 \cup S_{lat}$. Σ étant vide de charge, le théorème de Gauss s'écrit :

$$\iint\limits_{\Sigma} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint\limits_{S_1} \overrightarrow{E}_1 \cdot \overrightarrow{dS_1} + \iint\limits_{S_2} \overrightarrow{E}_2 \cdot \overrightarrow{dS} + \iint\limits_{S_lat} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS}_{lat}$$

$$-\iint_{S_1} E_1 \times dS_1 \qquad \iint_{S_2} E_2 \times dS_2 \qquad =0$$

qui donne en supposant le champ constant sur chacune base du tube :

$$E_2 = E_1 \times \frac{S_1}{S_2} \implies \boxed{E_2 > E_1}$$

A retenir :

- ▶ Un resserrement des lignes de champ correspond à une augmentation de l'intensité du champ électrostatique.
- ▶ Un évasement des lignes de champ correspond à une diminution de l'intensité du champ électrostatique.

Un exemple élémentaire est celui du champ engendré par une charge ponctuelle : l'intensité du champ électrique augmente à mesure que l'on se rapproche de cette dernière, et l'on constate également un resserrement des lignes de champ qui converge vers la charge pontuelle :

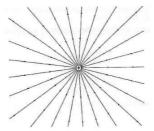
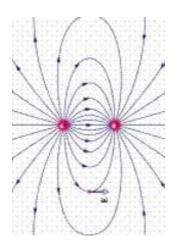
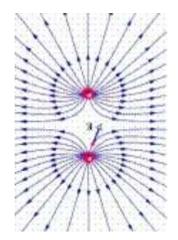


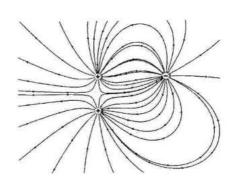
FIGURE XI.27 – Intensité du champ et resserrement/évasement des lignes de champ pour 1 charge ponctuelle

VIII.5 Quelques cartes de champs et d'isopotentielles

Quelques exemples de cartes de champ électriques (2D) à commenter :







deux charges opposées

Figure XI.28 - Topographie des Figure XI.29 - Topographie des Figure XI.30 - Topographie des lignes de champ électrique pour lignes de champ électrique pour lignes de champ électrique pour deux charges identiques q > 0

trois charges (+q, +q, -q)

Exercice de cours: (VIII.5) - n° 6. Tracer sur ces trois spectres de lignes de champ quelques courbes is opotentielles.